

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 3 部門第 1 区分

【発行日】平成24年4月19日 (2012.4.19)

【公表番号】特表2011-513181(P2011-513181A)

【公表日】平成23年4月28日 (2011.4.28)

【年通号数】公開・登録公報2011-017

【出願番号】特願2010-549003(P2010-549003)

【国際特許分類】

C 0 1 G 15/00 (2006.01)

H 0 1 L 31/04 (2006.01)

【F I】

C 0 1 G 15/00 B

H 0 1 L 31/04 E

【手続補正書】

【提出日】平成24年3月5日 (2012.3.5)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

銅インジウム硫化物半導体ナノ粒子を調製する方法であって、

(a) 銅塩、インジウム塩及びアルカンチオールを無極性有機溶媒に添加し、次いで不活性ガス下で加熱及び攪拌し、そして暗赤色のコロイド溶液が得られるまで溶解させる工程と、

(b) 前記工程(a)で得られた前記コロイド溶液を室温まで冷却し、極性溶媒を添加し、次いで遠心沈降を行って前記銅インジウム硫化物半導体ナノ粒子を得る工程と、を含むことを特徴とする方法。

【請求項 2】

得られた前記銅インジウム硫化物半導体ナノ粒子をさらに洗浄し真空乾燥して、前記銅インジウム硫化物半導体ナノ粒子の粉末を得ることを特徴とする請求項 1 に記載の方法。

【請求項 3】

前記洗浄は、得られた前記銅インジウム硫化物半導体ナノ粒子を、ヘキサン、クロロホルム又はトルエン溶媒中に分散させ、続いてメタノールを添加し、そして前記遠心沈降を進めることによって行われることを特徴とする請求項 2 に記載の方法。